Versuch B-1

Nichtlineare Zweipole und Transistoren

Inhaltsverzeichnis

Al	obild	ıngsverzeichnis					
Ta	belle	enverzeichnis]				
2	Vor 2.1 2.2	bereitung Dioden	1				
4	Aus	Auswertung					
	4.1 4.2 4.3	<u> </u>	12 15				
Α	bbil	dungsverzeichnis					
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	Ausgangskennlinie eines Transistors	10 10 10 10 10				
T.	ahal	llenverzeichnis					
T	1	Temperaturabhängiger Widerstand: Strom- und Widerstandswerte	15				

2 Vorbereitung

Die Versuchsvorbereitung ist Bestandteil des Versuchs. Sie erhalten dafür ein gesondertes Testat. Ohne testierte Vorbereitung können Sie den Versuch nicht durchführen.

2.1 Dioden

a) Skizzieren Sie die Strom-Spannungskennlinie einer idealen Diode.

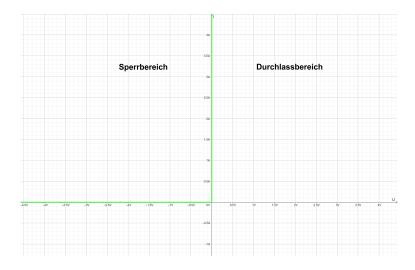


Abbildung 1: Strom-Spannungskennlinie einer idealen Diode

b) Skizzieren Sie die Strom-Spannungskennlinie einer Leuchtdiode (LED 8MM RT von reichelt).

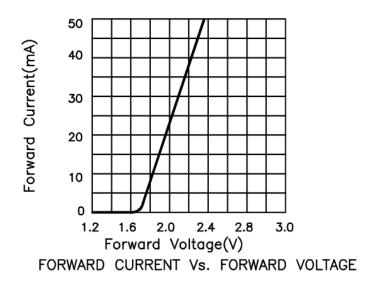
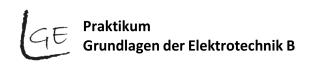


Abbildung 2: Strom-Spannungskennlinie von LED 8MM RT



c) Diese Diode soll in Reihe mit einem Vorwiderstand an einer Spannungsquelle mit 3 V betrieben werden. Geben Sie das zugehörige Schaltbild an und bestimmen Sie grafisch den benötigten Widerstandswert.

$$R_v = \frac{U_R}{I}$$

$$R_v = \frac{U - U_D}{I}$$

$$R_v = \frac{3 V - 2 V}{23 mA} = 43,48 \Omega$$

d) "3 Werte je Dekade im logarithmisch konstanten Abstand" Was heißt das? Fertigen Sie dazu eine Skizze an.

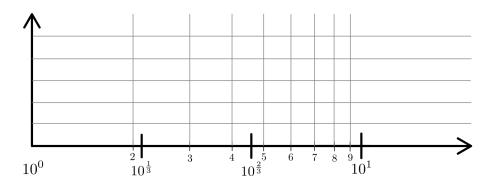


Abbildung 3: logarithmisch Skalierung

e) Warum unterscheidet sich die Spannung an der Diode bei der Spannungsfehlerschaltung bei gleichem Strom in den unterschiedlichen Strommessbereichen?

Für die unterschiedlichen Strommessbereichen hat das Messgerät unterschiedliche Innenwiderstände, deswegen verändert sich den Spannungsabfall an dem Messgerät.

f) Wie müssen Sie den Strom bei der Stromfehlerschaltung korrigieren? Leiten Sie her!

$$I_{mess} = I_x + I_U$$

$$I_x = I_{mess} - I_U$$

$$I_x = I_{mess} - \frac{U_m}{R_U}$$

g) Bereiten Sie mit Excel oder einem vergleichbaren Programm Ihrer Wahl die Tabellen zur Aufnahme der Messwerte vor, so dass nach Eingabe der Messwerte die geforderten Diagramme automatisch erstellt werden. Werden nur Messwerte dargestellt, erfolgt die Darstellung als Linie mit Markierung (Kreuz, Dreieck, Quadrat) der Messwerte. Sollen in einem Diagramm der theoretische Verlauf und die Messwerte dargestellt werden, so wird der theoretische Verlauf als Linie mit mindestens 100 Stützwerten und die Messwerte mit Kreuz, Dreieck oder Quadrat markiert.

2 VORBEREITUNG 2 Seite 2 von 16

2.2 Transistor

a) Skizzieren Sie die Eingangskennlinie eines Transistors (BCY 59-8).

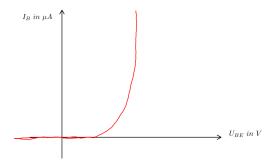


Abbildung 4: Eingangskennlinie eines Transistors

b) Skizzieren die das Ausgangskennlinienfeld eines Transistors (BCY 59-8).

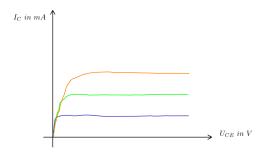


Abbildung 5: Ausgangskennlinie eines Transistors

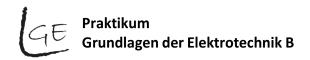
c) Welche Stromverstärkung hat dieser Transistor in etwa und wie kann sie aus den Messwerten ermittelt werden?

$$h_{FE} = \beta = \frac{I_C}{I_B}$$

		BCY58-VIII BCY59-VIII	
		MIN	MAX
h_{FE}	V_{CE} =5.0V, I_{C} =10 μ A	20	-
h_{FE}	V_{CE} =5.0V, I_{C} =2.0mA	180	310
h_{FE}	V_{CE} =1.0V, I_{C} =10mA	120	400
h_{FE}	V_{CE} =1.0V, I_{C} =100mA	45	-

Abbildung 6: Stromverstärkung des Transistors

2 VORBEREITUNG 3 Seite 3 von 16



Versuch B-1

Nichtlineare Zweipole und Transistoren

d) Bereiten Sie mit Excel oder einem vergleichbaren Programm Ihrer Wahl die Tabellen zur Aufnahme der Messwerte vor, so dass nach Eingabe der Messwerte die geforderten Diagramme automatisch erstellt werden. Werden nur Messwerte dargestellt, erfolgt die Darstellung als Linie mit Markierung (Kreuz, Dreieck, Quadrat) der Messwerte. Sollen in einem Diagramm der theoretische Verlauf und die Messwerte dargestellt werden, so wird der theoretische Verlauf als Linie mit mindestens 100 Stützwerten und die Messwerte mit Kreuz, Dreieck oder Quadrat markiert.

4 Auswertung

4.1 Dioden

a) Stellen Sie die Kennlinien im linearen Maßstab dar, benutzen Sie dazu die korrigierten Messwerte (Spannungsfehlerschaltung beachten, Durchlassrichtung und Sperrrichtung unterschiedliche Maßstäbe, ggf. je zwei Diagramme).

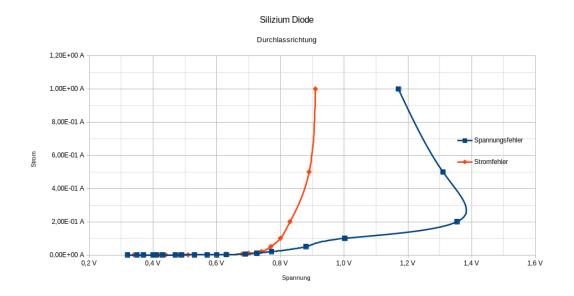


Abbildung 7: Silizium Diode in Durchlassrichtung

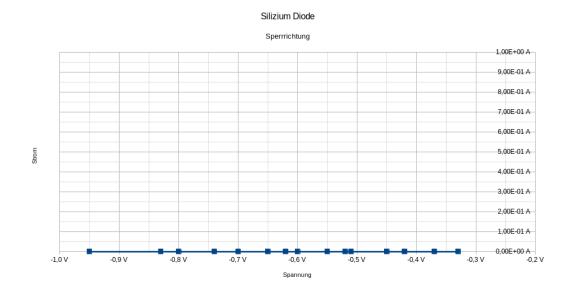


Abbildung 8: Silizium Diode in Sperrrichtung

4 AUSWERTUNG 5 Seite 5 von 16

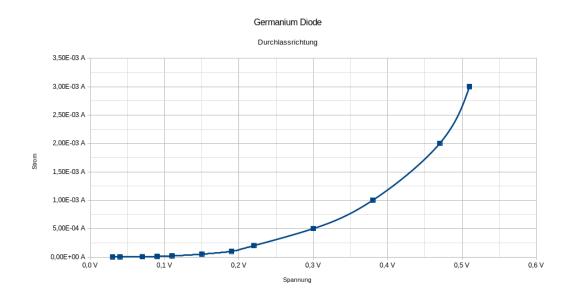


Abbildung 9: Germanium Diode in Durchlassrichtung

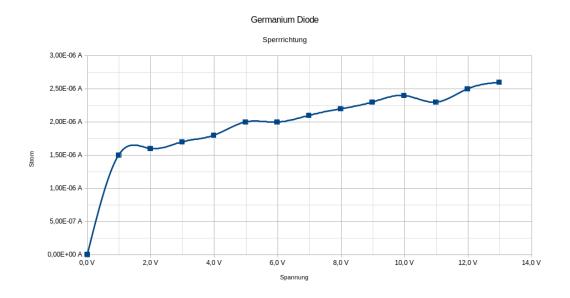


Abbildung 10: Germanium Diode in Sperrrichtung

4 AUSWERTUNG 6 Seite 6 von 16

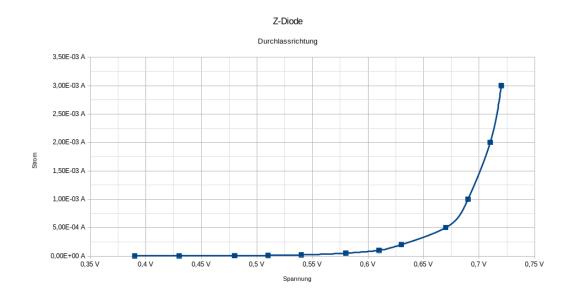


Abbildung 11: Z-Diode in Durchlassrichtung

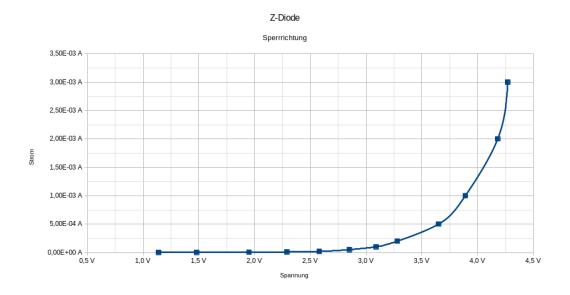
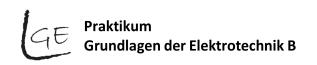


Abbildung 12: Z-Diode in Sperrrichtung

AUSWERTUNG 7 Seite 7 von 16



b) Berechnen Sie die Kennlinie der Si-Diode nach Gleichung 7, ermitteln Sie den Sperrstrom I_s und den Emissionskoeffizienten m aus den Messungen. (Tipp: Den Emissionskoeffizienten bestimmen Sie, indem Sie zwei Messwerte in Gleichung 7 einsetzen und beide Gleichungen dividieren, so dass der Sperrstrom gekürzt werden kann. Diese Gleichung kann nun nach m umgestellt werden.)

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{I_s \cdot \left(e^{\frac{U_1}{m \cdot U_T}} - 1\right)}{I_s \cdot \left(e^{\frac{U_2}{m \cdot U_T}} - 1\right)}$$

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{e^{\frac{U_1}{m \cdot U_T}} - 1}{e^{\frac{U_2}{m \cdot U_T}} - 1}$$

Die Rechnung lässt sich viel vereinfachen, wenn $e^{\frac{U}{m \cdot U_t}} >> 1$ ist. Annahme: $m = m_{max} = 2$ und $10^3 >> 1$

$$\begin{split} e^{\frac{U_{min}}{m_{max} \cdot U_t}} &\geq 10^3 \\ \frac{U_{min}}{m_{max} \cdot U_t} &\geq 3 \cdot \ln(10) \\ \frac{U_{min}}{2 \cdot 25, 3 \cdot 10^{-3} \ V} &\geq 3 \cdot \ln(10) \\ U_{min} &\geq \frac{151, 8 \cdot \ln(10)}{10^3} \ V \\ U_{min} &\geq 0, 35 \ V \\ &\Rightarrow \frac{I_1}{I_2} &= \frac{e^{\frac{U_1}{m \cdot U_T}}}{\frac{U_2}{m \cdot U_T}} \\ &\frac{I_1}{I_2} &= e^{\frac{U_1 - U_2}{m \cdot U_T}} \\ \ln\left(\frac{I_1}{I_2}\right) &= \frac{U_1 - U_2}{m \cdot U_T} \\ m &= \frac{U_1 - U_2}{\ln\left(\frac{I_1}{I_2}\right) \cdot U_T} \\ m &= \frac{0, 4 \ V - 0, 89 \ V}{\ln\left(\frac{5 \ \mu A}{0, 5 \ A}\right) \cdot 25 \cdot 10^{-3} \ V} = 1,68 \\ I_s &= \frac{I_1}{e^{\frac{U_1}{m \cdot U_T}} - 1} \\ I_s &= \frac{5 \ \mu A}{e^{\frac{0, 4 \ V}{1.68 \cdot 25, 3 \cdot 10^{-3} \ V} - 1}} = 4,029 \cdot 10^{-10} A \\ I &= 4,029 \cdot 10^{-10} \ A \cdot \left(e^{\frac{U}{42, 5 \cdot 10^{-3} \ V}} - 1\right) \end{split}$$

4 AUSWERTUNG 8 Seite 8 von 16

c) Stellen Sie die gemessene und berechnete Kennlinie der Si-Diode im halblogarithmischen Maßstab dar (berechnete Kennlinie als Linie, Messwerte als Punkte).

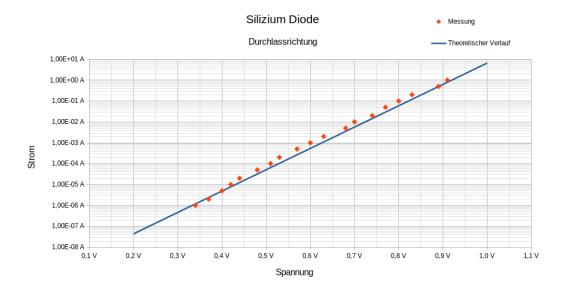


Abbildung 13: Kennlinie der Si-Diode aus dem theoretischem Verlauf und der Messungen

d) Beschriften Sie die fünf aufgenommenen Oszillogramme eindeutig.

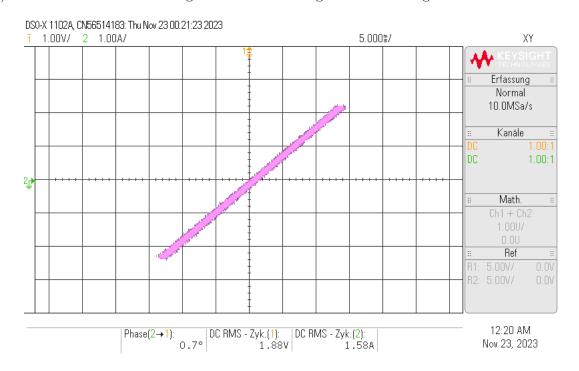


Abbildung 14: Oszillogramm des ohmschen Widerstands

4 AUSWERTUNG 9 Seite 9 von 16

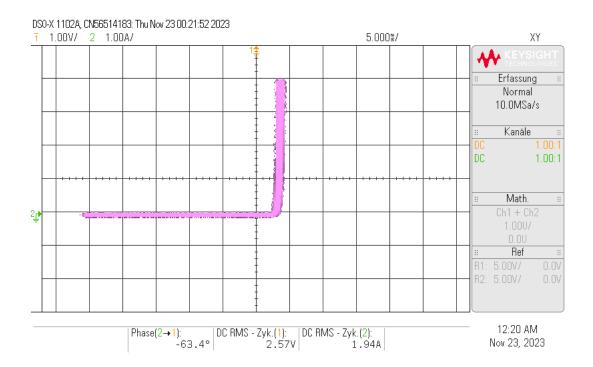


Abbildung 15: Oszillogramm der Si-Diode

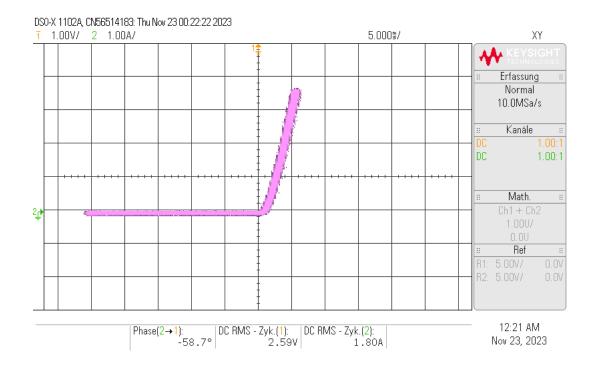


Abbildung 16: Oszillogramm der Germanium-Diode

4 AUSWERTUNG 10 Seite 10 von 16

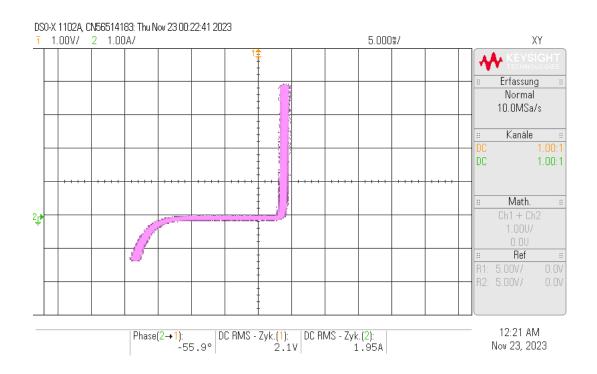


Abbildung 17: Oszillogramm der Z-Diode

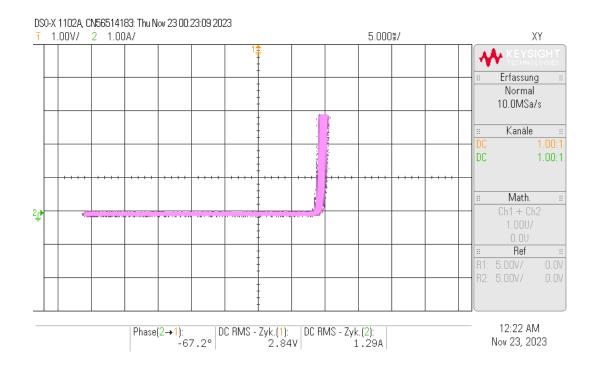


Abbildung 18: Oszillogramm der Leuchtdiode

4 AUSWERTUNG 11 Seite 11 von 16

4.2 Temperaturabhängiger Widerstand

a) Ermitteln Sie für jeden Messwert den Widerstand (Spannungsfehlerschaltung beachten!)

$\overline{ \ \ } \text{Temperatur in } {}^{\circ}C$	Strom in mA	Widerstand in Ω
22,5	2	1000,00
25	2,2	909,09
30	2,4	833,33
35	2,7	740,74
40	2,9	689,66
45	3,5	571,43
50	4	500,00
55	5	400,00
60	6	333,33
65	6,7	298,51
70	8,6	$232,\!56$
75	10	200,00
80	10,5	190,48
85	13	153,85
90	15	133,33
95	20	100,00
100	35	57,14

Tabelle 1: Temperaturabhängiger Widerstand: Strom- und Widerstandswerte

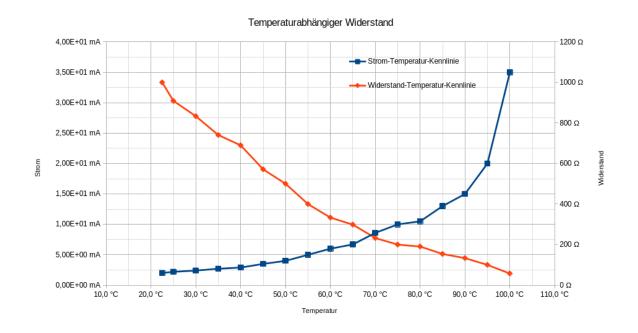


Abbildung 19: Strom-Temperatur-Kennlinie und Widerstand-Temperatur-Kennlinie

4 AUSWERTUNG 12 Seite 12 von 16



b) Berechnen Sie die Widerstandskennlinie näherungsweise nach Gleichung 8. Die Werkstoffkonstanten A und B sind aus den Messwerten bei minimaler und maximaler Temperatur zu ermitteln.

$$R(T) = A \cdot e^{\frac{B}{T}}$$

$$A = \frac{R(T)}{e^{\frac{B}{T}}}$$

$$\frac{R(T_1)}{R(T_2)} = \frac{A}{A} \cdot \frac{e^{\frac{B}{T_1}}}{e^{\frac{B}{T_2}}}$$

$$\frac{R(T_1)}{R(T_2)} = e^{\frac{B \cdot T_2 - B \cdot T_1}{T_1 \cdot T_2}}$$

$$\ln\left(\frac{R(T_1)}{R(T_2)}\right) = \frac{B \cdot (T_2 - T_1)}{T_1 \cdot T_2}$$

$$B = \frac{\ln\left(\frac{R(T_1)}{R(T_2)}\right) \cdot T_1 \cdot T_2}{(T_2 - T_1)}$$

$$B = \frac{\ln\left(\frac{1000 \Omega}{57,14 \Omega}\right) \cdot (295,65 K \cdot 374,15 K)}{(374,15 K - 295,65 K)}$$

$$B = 4033 K$$

$$A = \frac{R(T_1)}{e^{\frac{B}{T_1}}} = \frac{1000 \Omega}{e^{\frac{4033 K}{295,65 K}}}$$

$$A = 1,19 m\Omega$$

$$R(T) = 1,19 m\Omega \cdot e^{\frac{4033 K}{T}}$$

c) Stellen Sie beide Kennlinien in einem Diagramm da (berechnete Kennlinie als Linie, Messwerte als Punkte).

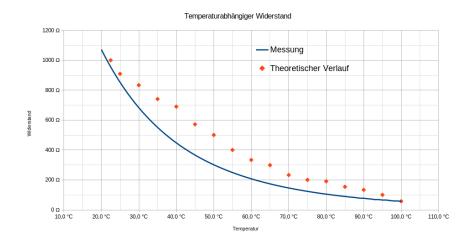
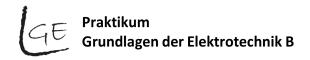


Abbildung 20: Widerstandskennlinie aus dem theoretischem Verlauf und der Messungen

4 AUSWERTUNG 13 Seite 13 von 16



Versuch B-1

Nichtlineare Zweipole und Transistoren

d) Vergleichen Sie die Kennlinien.

In der Abbildung 20 ist der Verlauf der Messdaten in Orange über dem theoretischen Verlauf in Blau dargestellt. Beide Verläufe, sowohl der theoretische als auch der gemessene, zeigen eine exponentiell abnehmende Charakteristik.

Die Abweichung zwischen den beiden Verläufen resultiert aus der Herausforderung der präzisen Temperaturmessung. Die Temperatur kann nicht exakt erfasst werden. Zusätzlich gestaltet sich die genaue Ablesung des Stroms als problematisch, da die Temperatur schnell abnimmt, was zu schnellen Änderungen in der Stromstärke führt.

4.3 Transistor

a) Stellen Sie die Eingangskennlinien nach 3.4.1 im linearen Maßstab in einem Diagramm dar.

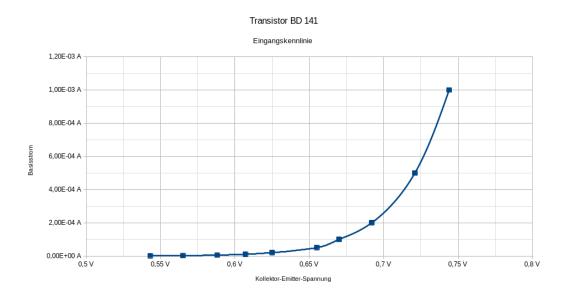


Abbildung 21: Eingangskennlinien des Transistors

b) Stellen Sie das Ausgangskennlinienfeld nach 3.4.2 im linearen Maßstab in einem Diagramm dar.

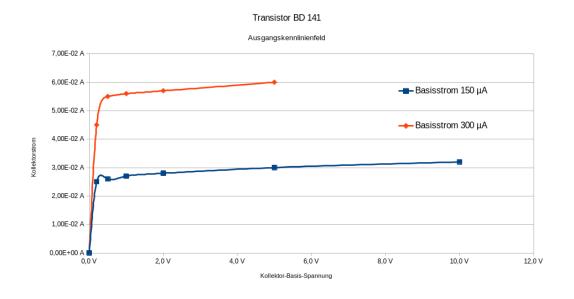
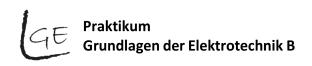


Abbildung 22: Ausgangskennlinienfeld des Transistors

4 AUSWERTUNG 15 Seite 15 von 16



c) Beschriften Sie das aufgenommene Oszillogramm eindeutig.

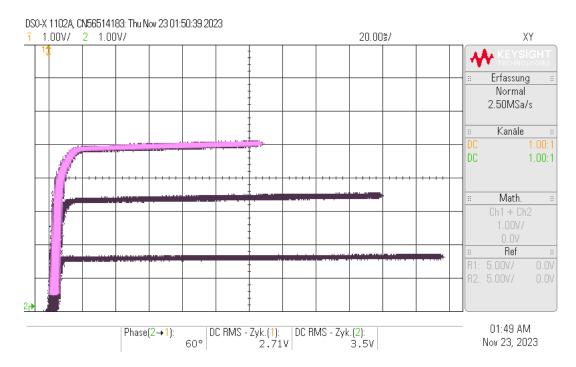


Abbildung 23: Oszillogramm der Ausgangskennlinienfelder

4 AUSWERTUNG 16 Seite 16 von 16